

**薄膜材料デバイス研究会 第19回研究集会「新半導体材料・デバイス：SDGs実現へ向けて」  
タイムテーブル（2日目）**

日付	時間	セッション	備考	座長(案)
11/18 (金)	9:30 - 11:10	<p>オールラセッション3：新奇薄膜材料・新奇デバイス</p> <p>9:30~10:10 (招待講演) 「ハロゲン化物エレクトロニクスの展望および課題」 Junghwan Kim (東工大)</p> <p>10:10~10:30 「水素添加多結晶In-Ga-0 (IG0:H) 薄膜の金属-半導体遷移制御と 薄膜トランジスタ応用」 松村 俊宏 (高知工大)</p> <p>10:30~10:50 「超高真空スパッタリング装置を用いた高移動度多結晶Zn<sub>3</sub>N<sub>2</sub>薄膜」 清水 篤 (東工大)</p> <p>10:50~11:10 「Solid-State Electrochemical Thermal Transistors based on Sr(Co<sub>1-x</sub>Fe<sub>x</sub>)O<sub>y</sub> (0 ≤ x ≤ 1, 2 ≤ y ≤ 3) Films as Active Layers」 Zhiping Bian (北大)</p>	響都ホール オンライン配信	太田 裕道 (北大) 市川 和典 (松江高専)
	11:10 - 11:25	企業コマercial③・休憩		
	11:25 - 12:45	<p>オールラセッション4：薄膜の物理・化学</p> <p>11:25~11:45 「Room Temperature Insulator-to-Metal Transition of Strained VO<sub>2</sub>/TiO<sub>2</sub> Multilayered Films」 Binjie Chen (北大)</p> <p>11:45~12:05 「ZnO中の水素複合欠陥」 Xinyi He (東工大)</p> <p>12:05~12:25 「原子状水素アニールによる半導体と金属の自然酸化膜と熱酸化膜の還元」 部家 彰 (兵庫県大)</p> <p>12:25~12:45 「タンパク質分子接合を含むCNTサブモノレイヤーFETによる電荷輸送特性評価」 森岡 璃久 (奈良先端大)</p>		木村 睦 (龍谷大) 春田 正和 (近畿大)
	12:45 - 13:40	昼食		
	13:40 - 14:15	ショートプレゼンテーション	響都ホール オンライン配信	葉 文昌 (島根大) 野々口 斐之 (京都工繊大)
	14:15 - 15:45	ポスターセッション	響都ホール (配信なし)	
	15:45 - 17:25	<p>オールラセッション5：パワーデバイスの新展開</p> <p>15:45~16:25 (招待講演) 「自動車用パワーデバイス開発の現状とキー課題」 三宅裕樹 ((株)ミライズテクノロジー)</p> <p>16:25~16:45 「スパッタリング法によるアモルファス酸化ガリウム薄膜の作製とダイオード特性の評価」 嵯峨野 太一 (東工大)</p> <p>16:45~17:05 「Development of a Real-Time Temperature Measurement Technique for SiC Wafer During Rapid Plasma Processing Based on Optical-Interference Contactless Thermometry (OICT)」 Jiawen Yu (広島大)</p> <p>17:05~17:25 「p型二硫化モリブデンTFTの原子状酸素処理及びアニール処理による特性改善」 荒井 大地 (日大)</p>	響都ホール オンライン配信	川原村 敏幸 (高知工大) 西中 浩之 (京都工繊大)
	17:25 - 17:40	企業コマercial④・休憩 15分		
	17:40 - 18:00	閉会式、アワード		